

CentralTM Semiconductor Corp.

145 Adams Avenue, Hauppauge, NY 11788 USA
Tel: (631) 435-1110 • Fax: (631) 435-1824

Manufacturers of World Class Discrete Semiconductors

1N3600
1N4150

SILICON SWITCHING DIODE

JEDEC DO-35 CASE

DESCRIPTION

The CENTRAL SEMICONDUCTOR 1N3600, 1N4150, silicon planar epitaxial diode is characterized by its miniature size, ultra fast switching speed, low capacitance, low leakage, and high conductance. Accordingly, it is ideally suited for applications such as pulse applications, avalanche circuits, core drivers, and for any critical circuit requiring high conductance at power dissipation without sacrificing fast recovery capability. (Both devices have identical electrical and mechanical specifications).

MAXIMUM RATINGS ($T_A=25^\circ\text{C}$)

| | SYMBOL | | UNIT |
|---|----------------|-------------|------------------|
| Peak Working Inverse Voltage | V_{RWM} | 50 | V |
| Average Forward Current | I_O | 200 | mA |
| Forward Steady State Current | I_F | 400 | mA |
| Recurrent Peak Forward Current | i_f | 600 | mA |
| Peak Forward Surge Current (1.0s Pulse) | I_{FSM} | 1.0 | A |
| Peak Forward Surge Current (1.0us Pulse) | I_{FSM} | 4.0 | A |
| Power Dissipation | P_D | 500 | mW |
| Operating and Storage Junction Temperature | T_J, T_{STG} | -65 to +200 | $^\circ\text{C}$ |

ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_A=25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

| SYMBOL | TEST CONDITIONS | MIN | MAX | UNIT |
|----------|--|------|------|---------------|
| I_R | $V_R=\text{Rated } V_{RWM}$ | | 100 | nA |
| I_R | $V_R=\text{Rated } V_{RWM}, T_A=150^\circ\text{C}$ | | 100 | μA |
| BV_R | $I_R=5.0\mu\text{A}$ | 75 | | V |
| V_F | $I_F=1.0\text{mA}$ | 0.54 | 0.62 | V |
| V_F | $I_F=10\text{mA}$ | 0.66 | 0.74 | V |
| V_F | $I_F=50\text{mA}$ | 0.76 | 0.86 | V |
| V_F | $I_F=100\text{mA}$ | 0.82 | 0.92 | V |
| V_F | $I_F=200\text{mA}$ | 0.87 | 1.0 | V |
| C | $V_R=0\text{V}, f=1.0\text{MHz}$ | | 2.5 | pF |
| t_{fr} | $V_{fr}=1.0\text{V}, I_f=200\text{mA}, t_r=0.4\text{ns}$ | | 10 | ns |
| t_{rr} | $I_f=I_r=10\text{mA to } 200\text{mA}, R_L=100\Omega$ | | 4.0 | ns |
| t_{rr} | $I_f=I_r=200\text{mA to } 400\text{mA}, R_L=100\Omega$ | | 6.0 | ns |

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Central Semiconductor:](#)

[1N4150](#) [1N3600](#) [1N3600 TR](#)

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9